DIALOG(R) File 352: Derwent WPI

(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

WPI Acc No: 1995-057619/199508

Related WPI Acc No: 1994-126652; 1995-057625; 1995-119468; 1996-115797;

1996-354057; 1997-525878; 1998-250670; 1999-546017; 2000-008055

XRAM Acc No: C95-026091 XRPX Acc No: N95-045496

Liq. crystal electro-optical devices - produced by controlling pptn.

position of non-hardening resin

Patent Assignee: SEMICONDUCTOR ENERGY LAB (SEME)
Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week

JP 6337405 A 19941206 JP 93148544 A 19930527 199508 B

Priority Applications (No Type Date): JP 93148544 A 19930527

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 6337405 A 6 G02F-001/1333

Title Terms: LIQUID; CRYSTAL; ELECTRO; OPTICAL; DEVICE; PRODUCE; CONTROL;

PRECIPITATION; POSITION; NON; HARDEN; RESIN

Derwent Class: LO3; P81; U14; V07

International Patent Class (Main): G02F-001/1333

International Patent Class (Additional): GO2F-001/1337; GO2F-001/1339

File Segment: CPI; EPI; EngPI

DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

LIQUID CRYSTAL ELECTRO-OPTICAL DEVICE AND MANUFACTURE THEREOF

PUB. NO.: 06-337405 [JP 6337405 A]

PUBLISHED: December 06, 1994 (19941206)

INVENTOR(s): NISHI TAKESHI

KONUMA TOSHIMITSU

SHIMIZU MICHIO

APPLICANT(s): SEMICONDUCTOR ENERGY LAB CO LTD [470730] (A Japanese Company or Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.: 05-148544 [JP 93148544]

FILED: May 27, 1993 (19930527)

INTL CLASS: [5] G02F-001/1333; G02F-001/1337; G02F-001/1339

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 14.2

(ORGANIC CHEMISTRY -- High Polymer Molecular Compounds)

JAPIO KEYWORD: R011 (LIQUID CRYSTALS); R119 (CHEMISTRY -- Heat Resistant Resins)

ABSTRACT

PURPOSE: To uniformize display, and improve a contrast ratio by arranging a hydrophobic an/or gydrophilic part selectively on a surface of a substrate, and controlling a position to deposit uncured resin from mixture of a liquid crystal and unhardened resin.

CONSTITUTION: Mixture of a biphenyl type ferroelectric liquid crystal material 118 and unhardened high polymer resin is injected into a cell constituted in such a way that a picture element electrode 113 and an active matrix 114 formed by using crystalline silicon TFT are formed on non-alkaline glass 111 and an ITO film 116 and an oriented film 117 are formed on the other substrate 112 and both substrates 111 and 112 are adhered and fixed to each other thorugh a spacer 119. In a process to form a resin spacer (polymerization column spacer, PCS) 120 cured into a column shape by depositing unhardened resin from this mexture, in the first place, a liquid crystal material is deposited and oriented in a part whose surface is not pressed and which holds a hydropholic property, and next, resin is deposited in a part becoming a hydrophobic property by being pressed. Thereby, in an optional case, the PCS 120 can be deposited, and display can be uniformized.

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

特開平6-337405

(43)公開日 平成6年(1994)12月6日

(51) Int.Cl.⁶

酸別配号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

G02F

1/1333

9317-2K

1/1337

8507-2K

1/1339

8507-2K

審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全 6 頁)

(21)出願番号

特願平5-148544

500

(71)出願人 000153878

株式会社半導体エネルギー研究所

神奈川県厚木市長谷398番地

(22)出願日 平成5年(1993)5月27日

(72)発明者 西 毅

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半

導体エネルギー研究所内

(72)発明者 小沼 利光

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半

導体エネルギー研究所内

(72)発明者 清水 美知緒

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半

導体エネルギー研究所内

(54) 【発明の名称】 液晶電気光学装置およびその作製方法

(57)【要約】

【目的】液晶材料と未硬化樹脂との混合物中から未硬化 樹脂を析出、硬化して形成したカラム状樹脂を有する液 晶電気光学装置を作製するに際し、未硬化樹脂の析出位 置を任意に制御する。

【構成】 一対の基板間に、液晶材料と未硬化樹脂との 混合物を挟持させ、該混合物中から前記未硬化樹脂をカ ラム状に析出させた後硬化させるに際し、前記一対の基 板のうち少なくとも一方の基板の前記液晶混合物に接す る面の表面に、疎水性を有する部分および/または親水 性を有する部分を選択的に設ける。

【特許請求の範囲】

【請求項1】一対の基板間に、液晶材料と未硬化樹脂と の混合物を挟持させ、該混合物中から前記未硬化樹脂を カラム状に析出させた後硬化させるに際し、前記一対の 基板のうち少なくとも一方の基板の前記液晶混合物に接 する面の表面に、疎水性を有する部分および/または親 水性を有する部分とを選択的に設けることにより、前記 未硬化樹脂の析出位置を制御することを特徴とする液晶 電気光学装置作製方法。

【請求項2】一対の基板間に、液晶材料と未硬化樹脂と の混合物を挟持させ、該混合物中から前記未硬化樹脂を カラム状に析出させた後硬化させるに際し、前記一対の 基板のうち少なくとも一方の基板の前記液晶混合物に接 する面の表面に対し、線状あるいは格子状の形状を有す る物質で押圧することで、前記未硬化樹脂の析出位置を 制御することを特徴とする液晶電気光学装置作製方法。

【請求項3】一対の基板間に液晶材料と、前記一対の基 板のうち少なくとも一方の内側面上に前記液晶材料を一 軸配向させる配向手段とを有し、前記基板間には前記液 形成した壁状の樹脂を有することを特徴とする液晶電気 光学装置。

【請求項4】請求項3において、壁状の樹脂は各画素の 周りに存在することを特徴とする液晶電気光学装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】本発明は、液晶材料と未硬化樹脂との混合 物中から未硬化樹脂を析出、硬化して形成したカラム状 樹脂を有する液晶電気光学装置の作製方法に関する。

[0002]

【従来の技術】最近、大面積の液晶ディスプレイが注目 30 されている。しかしながら大面積化することで基板自身 にたわみが生じ、例えば液晶材料として強誘電性液晶を 用いた場合、強誘電性液晶は層構造を有しているため基 板が変形することによってこの層構造が崩れ、表示に支 障がでてしまい、大面積化できないという問題があっ た。この問題は、強誘電性液晶に限ったことではなく、 他の液晶材料を用いた場合でも基本的にいえることであ る。

【0003】また、従来においては、基板間隔を保つた めに基板間に保持された酸化珪素のスペーサーを用い、 さらに基板のたわみや膨らみをなくすために、やはり基 板間に保持された有機樹脂性の内部接着材料を用いてい た。スペーサーは文字通り、基板間隔を保持するための もので、その直径によって、基板間隔が決まるものであ る。また、基板同士を密着させるために用いられる有機 樹脂は、その直径が必要とする基板間隔よりも大きく、 基板間において潰れることによって、上下の基板同士を 密着せしめる作用を有するものである。

【0004】上記のような従来の構成においては、まず 基板上に配向処理を施し、つぎに一方の基板上に上記ス 50 物を挟持させ、前記透光性基板間において前記混合物中

ペーサーと内部接着材料を散布し、しかる後に基板同士 を張り合わせることによって、基板間隔を決定すると共 に、基板同士を張り合わせ、しかる後に基板間に液晶を 注入することを基本的な作製方法としていた。

【0005】しかしながら、上記従来の作製工程につい て検討したところ、液晶が配向規制力に従って配向せん とその状態が変化する際、上記基板同士を密着させるた めの樹脂材料が、液晶の配向せんとする動きを規制して いることが判明した。

【0006】上記の2つの問題、即ち、 10

- ・基板間隔を一定に保つ構成が必要である。
- ・液晶を配向させる際に、基板同士を密着させる材料が 液晶の配向に悪影響を与えている。

といった問題を解決する方法として、本発明者らが、特 願平5-55237に示した発明がある。

【0007】この発明は、一対の基板間に液晶材料及び 未硬化樹脂の混合物と、前記一対の基板のうち少なくと も一方の基板の内側面上に前記液晶材料を一定の方向に 配列させる配向手段を設け、前記液晶材料中に混入させ 晶材料中に混入させていた未硬化樹脂が析出、硬化して 20 ていた未硬化樹脂が析出、硬化したことによって形成さ れるカラム状の樹脂を有すること、を要旨とする液晶電 気光学装置である。

> 【0008】上記液晶電気光学装置の作製方法は、配向 処理を施した一対の相対向する基板間に、液晶材料と、 反応開始剤を添加した樹脂材料とを混合して封入し、液 晶を配向させた後に、紫外線照射等によって析出した樹 脂成分を硬化させ、この樹脂成分をカラム状(柱状)に 硬化形成することによって行う。

【0009】上記のような液晶材料中から析出させたカ ラム状の樹脂を、柱状の樹脂スペーサーという意味で重 合カラムスペーサー (Polymerized Column Spacer 、 P CSと略す)という。

【0010】上記構成の概要を図1を用いて説明する。 図1に示されているのは、アクティブマトリックス型の 液晶表示装置である。図1において、101、102は 透光性基板103、106は画素電極、104はスイッ チング素子、106は液晶材料を一定の方向に配列する ための配向手段、109は液晶材料である。液晶材料1 09は配向手段107に従って一軸配向している。一

方、液晶材料から分離析出した樹脂110がカラム状 (柱状)となって2枚の基板101、102上の配向手 段107に接着している。配向手段がどちらか一方の基 板側のみに形成されている場合、樹脂110は、例えば 配向手段107と、透光性基板102あるいは該基板と 電極103に接着している。

【0011】この液晶電気光学装置を作製するには、ス ペーサー108によって基板間隔が決められた電極10 3、106を有する一組の透光性基板101、102で 液晶材料と反応開始剤を添加した未硬化の樹脂との混合

から前記未硬化樹脂を析出させることによって、前記液 晶材料を配向手段に沿って配列させる。しかる後に前記 析出した未硬化樹脂を硬化するための手段を施すことに より前記未硬化樹脂が硬化しカラム(110で示され る)となって前記両基板を接着する。

【0012】図1に示す構成を採用した場合、液晶材料 109が配向手段107に従って配列した後に樹脂を硬 化させるため、硬化前の良好な配向状態を保つことが出 来、硬化後の樹脂が配向に与える影響は極めて少ない。 めると共に密着性を向上させるという効果と、液晶の配 向性を向上させるという効果を有する。

[0013]

【従来技術の問題点】上記構成は優れたものであるが、 カラム状樹脂が析出する位置は全く制御できず、液晶材 料と樹脂のそれぞれの析出位置が偏りを生じていると表 示状態の均一性が失われてしまっていた。また薄膜トラ ンジスタ等のスイッチング素子を有する液晶電気光学装 置においては、画素電極上に樹脂の析出が偏ると開口率 の低下を引き起こしてしまった。

【0014】また、液晶材料として強誘電性液晶を用い た場合、樹脂の析出箇所の偏りにより層構造が崩れて配 向欠陥が発生することがあり、これによってコントラス ト比の低下をまねいていた。

[0015]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、液晶材料と 未硬化樹脂との混合物中から未硬化樹脂を析出、硬化し て形成したカラム状樹脂を有する液晶電気光学装置を作 製するに際し、未硬化樹脂の析出位置を任意に制御する・ ことを目的とする。

[0016]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、本発明は、一対の基板間に、液晶材料と未硬化樹脂 との混合物を挟持させ、該混合物中から前記未硬化樹脂 をカラム状に析出させた後硬化させるに際し、前記一対 の基板のうち少なくとも一方の基板の前記液晶混合物に 接する面の表面に、疎水性を有する部分および/または 親水性を有する部分を選択的に設けることにより、前記 未硬化樹脂の析出位置を制御することを特徴とするもの である。

[0017]

【作用】本発明者らは、重合カラムスペーサ (PCS) を作製するに際し、液晶材料と未硬化樹脂との混合物 (以下液晶混合物という) 中から未硬化樹脂がカラム状 に析出する位置が、液晶混合物と接する基板表面のうち 疎水性を有する部分であることを発見した。つまり、液 晶混合物と接する基板表面に、意図的に疎水性を有する 部分を形成することでその場所に樹脂を析出させ、カラ ム状の樹脂スペーサとすることが可能となる。すなわ ち、樹脂が析出する位置を任意に制御することが可能と 50 った。

なった。

【0018】基板の表面の一部を疎水性するする方法と しては、例えば、基板周辺部をスールするシール材を印 刷する際に使用するスクリーン印刷の版が基板に接触す る際、版の縦糸及び横糸が接触する部分Aとそれ以外の 部分Bが生じ、結果的にAとBという表面状態が異なる 2つの部分が発生する。

【0019】このとき基板の表面は、版により表面を押 圧されているA部とそれ以外の部分とでは表面張力の極 このカラム状の硬化樹脂110は、基板間隔を保持せし 10 性が変化している。特に押圧された部分は疎水性になる 傾向にある。

> 【0020】上記のような基板の表面状態の異なる2つ の部分を有した液晶セルに、液晶材料と未硬化樹脂の混 合物を等方相を示す温度で注入し、室温まで徐冷する と、徐冷中にまず前記混合物が等方相から液晶相に転移 するときに上記のB部に液晶材料が析出し、さらに冷却 すると未硬化樹脂が上記A部に析出する。

【0021】その他、カップリング剤等を塗布したり、 炭素や弗素等の膜を形成したり、レーザ照射等を行うな 20 どして、基板の液晶混合物に接する面に親水性または疎 水性の部分を任意に設けることで、カラム状樹脂の析出 位置を指定できる。

【0022】このように本発明により、従来は全く制御 できなかったカラム状樹脂の形成される位置を、任意に 制御できるようになった。以下に実施例を示す。

[0023]

【実施例】

【0024】図2に液晶セルの構成を示す。液晶セルの 片方の基板111は無アルカリガラスであり、該基板上 30 には画素電極113及び結晶性シリコンTFTを使用し たアクティブマトリクス114を作製した。画素電極の 大きさは100μm口とした。TFTに接続している走 査電極と信号電極によって区切られるマトリクスの大き さは108μm□であった。なお、該基板上には絶縁膜 115を形成した。他方の基板112には全面にITO 膜116を形成した。電極のみが形成されている基板に は配向膜117を形成した。基板の間隔は1.5 μmで あった。

【0025】配向膜材料はポリイミド系の樹脂、例えば 40 LQ-5200 (日立化成製)、LP-64 (東レ 製)、RN-305 (日産化学製)等であり、ここでは LP-64を使用した。配向膜はn-メチルー2-ピロ リドン等の溶媒により希釈しスピンコート法により塗布 した。塗布した基板は250~300℃、ここでは28 0℃で2. 5時間加熱し溶媒を乾燥させ、塗膜をイミド 化し硬化させた。硬化後の膜厚は300Åであった。 【0026】次に配向膜をラビングする。ラビングはレ ーヨン、綿等の布が巻いてあるローラーで450~90 0 r p m、ここでは 4 5 0 r p m の回転数で一方向に擦

5

【0027】次に該セルの間隔を一定にするためスペー *をリー119として、配向膜が塗布されている側の基板には直径1.5 μ mの真絲球(触媒化成製)を散布した。また、他方の基板上には、該2枚の基板を固定するために、シール剤として基板の周辺に2液製のエポキシ系接着剤をスクリーン印刷により印刷塗布し、その後2枚の基板を接着固定した。このときスクリーン版の各縦糸および横糸と、走査電極および信号電極がそれぞれ重なるよう位置合わせを行った。本実施例におけるスクリーン版のメッシュ(25.4 μ m当りの、縦横の糸によって囲 10 る。まれた空間の数)は230、従って糸と糸との距離は走査電極と信号電極によって区切られる四角形空間の一辺と同じ長さである108 μ m、また、スクリーンを構成する糸の線径は35 μ mである。は核

【0028】上記セルには液晶材料118及び未硬化の高分子樹脂の混合物を注入する。液晶材料としてはビフェニル系の強誘電性液晶を使用した。この液晶は相系列がIso-SmA-SmC*-Cryを取る。構造式は

C8 H₁₇O-C₆ H₄ -C₆ H₄ -COO-C* HCH 3 C₂ H₅

C₁₀H₂₁O-C₆ H₄ -C₆ H₄ -COO-C* HCH 3 C₂ H₅

となっており、上記2種の材料が1:1で混合している。高分子樹脂としては市販の紫外線硬化型の樹脂を使用した。液晶材料と未硬化高分子樹脂は、重量比で85:15の割合で混合する。該混合体は均一に混ざるようにIso(等方)相になる温度で攪拌した。該混合体はIso相からSmA相への転移点が液晶材料のみの場合より、5~20℃低下した。

【0029】上記混合体の注入は、液晶セル及び混合体*30

E入は、液晶セル及び混合体*30 【表1】 押圧による表面張力(極性項成分)の変化

| 压力(kgf/cm²) | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 0 | 非接触 |
|---------------|-----|---|---|---|-----|-----|
| 表面張力(dyne/cm) | 1 0 | 7 | 5 | 5 | - 5 | 1 2 |

【0034】表1に示すように、押圧された部分はそれ以外の部分に比べ極性項成分の値が小さくなった。これは押圧された部分が疎水性になっていることを示している。また、ある圧力を持って、特に本実験では6kgf/cm²以上となると表面張力の大きさに変化が無くなる傾向となった。

【0035】PCSの形成過程は上述したように液晶混合物中の液晶材料が先ず配向し、徐冷が進むに従い樹脂材料が析出するものである。したがって樹脂が押圧された部分に析出する過程としては、表面の押圧されていない親水性を保持した部分にまず液晶材料が析出、配向し、次に押圧され疎水性となった部分に樹脂が析出することが説明される。

【0036】また、この時液晶材料中にはジグザグ欠陥 等の配向欠陥はほとんど見られなかった。

【0037】次に上記セルの高分子樹脂を硬化させるた 50

*を100℃とし真空下で行った。注入後、液晶セルは2~20℃/hr、ここでは3℃/hrの割合で徐冷した。

【0030】この液晶セルの配向状態を、偏光顕微鏡で直交ニコル下で観察したところある回転角で消光位、即ち片方の偏光板に入射した光が、他方の偏光板を透過せず、あたかも光が遮断された状態が得られた。このことは液晶材料が、ユニフォーム配向(液晶分子が基板間で一方向に配向している)となっていることを示している

【0031】また、未硬化樹脂は画素と画素の間即ちて FT及び電極配線部分にのみ析出し画素電極部分にはほ とんど樹脂が析出していないのが分かった。未硬化樹脂 は複屈折性を示さないので偏光顕微鏡下では光は透過せ ず黒色に見えた。この状態で液晶材料と未硬化樹脂を分 離できている。

【0032】上記のように押圧されていない部分は液晶材料が析出しやすくなっており、表面極性が押圧されている部分とそれ以外の部分とで異なっていることが予想された。このため、押圧による表面極性の変化を模擬的に実験した。実験では、配向膜上を円筒形の棒により押圧し、そのあとの表面張力を測定した。配向膜は上記と同じ配向膜で、また配向膜形成条件及びラビング条件を同じくしてガラス基板上に塗膜を形成した。次に配向膜上を直径1cmの円筒形の棒で押圧した。この時の圧力及び押圧された部分の表面張力の極性項成分、また押圧されていない部分の表面張力の極性項成分を表1に示す。

[0033]

め紫外線を照射した。照射強度は $3\sim30\,\mathrm{mW/c}$ m^2 、ここでは $10\,\mathrm{mW/c\,m^2}$ とし、照射時間は0. $5\sim5\,\mathrm{min}$ 、ここでは $1\,\mathrm{min}$ とした。

【0038】紫外線照射後、液晶セルの配向状態を上記 と同様に偏光顕微鏡下で観察したが配向状態はほとんど 40 変化しなかった。紫外線照射の配向状態に対する影響は 見られなかった。

【0039】上記液晶セルの光学特性を測定した。測定方法は、ハロゲンランプを光源とする偏光顕微鏡により、直交ニコル下で液晶セルの透過光強度をフォトマルチプライヤーで検出するものである。その結果を表2に示す。表2の結果によれば、硬化した高分子樹脂(以下PCS:Polymerized Column spacer、重合カラムスペーサーと記述する)120が電極部分にほとんど存在しないので開口率が高くなり高コントラスト比を有する。

[0040]

7

【表2】

コントラスト比の測定

| ON | 3 0 | |
|---------|-----|---|
| OFF | 0. | 6 |
| コントラスト比 | 5 0 | |

【0041】また、各画素の周りはプラックマトリクス の様に黒く表示されていた。

【0042】作製したセルは、セルを垂直にしても表示 10 状態には何等変化がなかった。これは液晶材料中に点在 する P C S が 2 枚の基板を内部接着し、基板間隔が一定 に保たれセルが瓢箪状に膨れてしまうことを防いでいる ためである。

【0043】次に液晶セルの断面を走査型電子顕微鏡で 観察した。液晶材料はアルコールにより抽出した。観察 結果によればPCSが2枚の基板間で画素電極上を除き 壁状形成されていた。

【0044】PCSの壁は、スイッチング素子及び画素 周りを囲っていた。

【0045】なお、本実施例では強誘電性液晶を使用し た場合について記述したが、本発明の構成は強誘電性液 晶のみに限定されるものではなく、ネマチック液晶等他 の液晶材料を使用した場合にも有効である。またアクテ ィブマトリクス型のみでなく単純マトリクス型において も有効である。

[0046]

【発明の効果】本発明により、セル内にて液晶材料と未 硬化樹脂との混合物中から未硬化樹脂を析出しカラム状 30 103、113・・・電極 に硬化させた樹脂スペーサ (重合カラムスペーサ=PC S)を有する液晶電気光学装置において、任意の場所に PCSを析出することが可能となり、液晶材料およびP CSの位置関係が液晶表示装置全体に渡って均一になり 表示状態が均一化した。

【0047】また、ジグザグ欠陥等の配向欠陥の発生を 防止でき、コントラスト比が向上した。

【0048】また、特に画素電極以外の部分のみに樹脂 を析出させることが可能となり、特に薄膜トランジスタ 等のスイッチング素子を各画素に接続したアクティブマ トリクス型液晶電気光学装置では、画素電極以外の、ス イッチング素子、走査電極、信号電極の上にのみPCS を形成させることで、開口率を向上させ、装置としての コントラスト比を向上させることができた。

【0049】また、スイッチング素子の上部にPCSが 形成された場合、PCSは光学的に等方性であるため、 液晶電気光学装置においては偏光板によりPCSの部分 は光が透過せず黒色状態となる。これにより、スイッチ ング素子への光による伝導度の変動を押さえるために通 常対向電極側の基板に形成される遮光膜と同等の役割を はたし、遮光膜の形成を不要とする。

【0050】また、画素以外の部分に壁状に連続したP CSを形成できるため、上述の遮光膜作用と同様、画素 電極の周りを黒く表示させうる。したがってカラーの液 晶電気光学装置で特に必要とされるブラックマトリクス の如き作用をも有する。単純マトリクス型の装置にて電 を接続する信号線及び走査線のほぼ直上にあり、画案の 20 極間に樹脂を形成した場合においても同様の効果を有す

【図面の簡単な説明】

【図1】 重合カラムスペーサーを含有した液晶電気光 学装置の概略図を示す。

【図2】 実施例による液晶電気光学装置の概略図を示 す。

【符号の説明】

101、111・・・基板

102、112・・・基板

104、114・・・薄膜トランジスタ

105、115・・・絶縁膜

106、116・・・電極

107、117・・・配向膜

108、118・・・スペーサー

109、119・・・液晶材料

110、120・・・ 重合カラムスペーサー

